

Содержание

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Электронные свойства полупроводников | |
| <p>Ромака В.А., Rogl P., Ромака В.В., Kaszowski D., Крайовский В.Я., Стадник Ю.В., Горынь А.М. Особенности зонной структуры и механизмов проводимости полупроводника <i>n</i>-HfNiSn, сильно легированного Y 147</p> <p>Шерченков А.А., Козюхин С.А., Лазаренко П.И., Бабич А.В., Богословский Н.А., Сагунова И.В., Редичев Е.Н. Электrofизические свойства и механизмы переноса в тонких пленках материалов фазовой памяти на основе халькогенидных полупроводников квазибинарного разреза GeTe–Sb₂Te₃ 154</p> <p>Гусейнов Дж.И., Мургузов М.И., Исмаилов Ш.С., Мамедова Р.Ф., Годжаев Э.М. Термоэдс и термомагнитные свойства твердых растворов Er_xSn_{1-x}Se 161</p> <p>Никитенко В.Р., Кудров А.Ю. Полсвая диффузия в неупорядоченных органических материалах в условиях заполнения глубоких состояний 166</p> <p>Вейнгер А.И., Тиснек Т.В., Кочман И.В., Окулов В.И. Магнитозависимое микроволновое поглощение в HgSe в слабых магнитных полях 172</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления <p>Авакянц Л.П., Асланян А.Э., Боков П.Ю., Положенцев К.Ю., Червяков А.В. Спектры электроотражения множественных квантовых ям InGaN/GaN, помещенных в неоднородное электрическое поле <i>p</i>–<i>n</i>-перехода 198</p> <p>Яфясов А.М., Божевольнов В.Б., Рюмцев Е.И., Ковшик А.П., Михайловский В.Ю. Новый механизм поляризации полупроводника на интерфейсе с органическим диэлектриком 202</p> <p>Шулейко Д.В., Заботнов С.В., Жигунов Д.М., Зеленина А.А., Каменских И.А., Кашкаров П.К. Фотолюминесценция аморфных и кристаллических кремниевых нанокластеров в сверхрешетках из нитрида и оксида кремния 205</p> <p>Ситников С.В., Косолобов С.С., Латышев А.В. Зарождение двумерных островков на Si(111) при высокотемпературном эпитаксиальном росте 212</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники <p>Валеев Р.Г., Тригуб А.Л., Чукавин А.И., Бельтюков А.Н. Структурные исследования нанокомпозитов ZnS:Cu (5 ат%) в пористом Al₂O₃ различной толщины 216</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Углеродные системы <p>Подливаев А.И., Опенов Л.А. Термическая устойчивость гидрированных углеродных нанотрубок малого диаметра 222</p> <p>Давыдов С.Ю. К теории адсорбции на графеноподобных соединениях 226</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Физика полупроводниковых приборов <p>Юрков С.Н., Мнацаканов Т.Т., Левинштейн М.Е., Тандоев А.Г., Palmour J.W. Анализ влияния неоднородных эффектов на отпирающий ток управления тиристорных структур на основе 4H-SiC 234</p> <p>Прудаев И.А., Копьев В.В., Романов И.С., Олейник В.Л. Влияние баллистической утечки на температурную зависимость квантового выхода светодиодов на основе множественных квантовых ям InGaN/GaN 240</p> <p>Мынбаев К.Д., Баженов Н.Л., Семакова А.А., Михайлова М.П., Стоянов Н.Д., Кижаяев С.С., Молчанов С.С., Астахова А.П., Черняев А.В., Lipsanen H., Бугров В.Е. Электролюминесценция светодиодных гетероструктур InAs/InAs(Sb)/InAsSbP в диапазоне температур 4.2–300 К 247</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки <p>Пятилова О.В., Гаврилов С.А., Шилиева Ю.И., Павлов А.А., Шаман Ю.П., Дудин А.А. Влияние типа и степени легирования на морфологию <i>por</i>-Si, полученного гальваническим травлением 182</p> <p>Привезенцев В.В., Кириленко Е.П., Горячев А.Н., Батраков А.А. Исследование кремния, легированного ионами цинка и отожженного в кислороде 187</p> <p>Леньшин А.С., Середин П.В., Кавецкая И.В., Минаков Д.А., Кашкаров В.М. Исследование особенностей осаждения органического красителя Родамин Б на поверхность пористого кремния с различным размером пор 193</p> | |



Ерофеев Е.В., Федин И.В., Кутков И.В., Юрьев Ю.Н.
Увеличение порогового напряжения отпираания силовых GaN-транзисторов при использовании низкотемпературной обработки в потоке атомарного водорода 253

Кузнецов П.И., Аверин С.В., Житов В.А., Захаров Л.Ю., Котов В.М.
МПМ детектор видимого диапазона длин волн на сверхрешетке ZnSe/ZnTe второго типа 258

Полубавкина Ю.С., Зубов Ф.И., Моисеев Э.И., Крыжановская Н.В., Максимов М.В., Семенова Е.С., Yvind K., Асрян Л.В., Жуков А.Е.
Особенности волноводной рекомбинации в лазерных структурах с асимметричными барьерными слоями 263

Закгейм А.Л., Ильинская Н.Д., Карандашев С.А., Лавров А.А., Матвеев Б.А., Ременный М.А., Стусь Н.М., Усикова А.А., Черняков А.Е.
Пространственное перераспределение излучения во флип-чип фотодиодах на основе двойных гетероструктур InAsSbP/InAs 269

• **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Крыжановская Н.В., Полубавкина Ю.С., Неведомский В.Н., Никитина Е.В., Лазаренко А.А., Егоров А.Ю., Максимов М.В., Моисеев Э.И., Жуков А.Е.
Исследование структурных и оптических свойств слоев GaP(N), синтезированных методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках Si(100) 4° 276

Аннотации статей, поступивших в Редакцию журнала на английском языке. Полные тексты этих статей опубликованы в переводной версии журнала „Физика и техника полупроводников“ — SEMICONDUCTORS

Arapov Yu.G., Gudina S.V., Klepikova A.S., Neve-rov V.N., Harus G.I., Shelushinina N.G., Yakunin M.V.
The temperature dependence of the conductivity peak values in the single and the double quantum well nanostructures n-InGaAs/GaAs after IR-illumination 281